



Det ledsagende billede kan downloades i både høj og lav opløsning ved at klikke her <https://publitektd.sharepoint.com/:f/s/PublitekFTP/Et3xPhnzjfVPtuZGbxVvPeABESJttduDcH0tPvhmwPjzqQ?e=mFGkbT>

Toshiba udvider serie af super junction N-kanal MOSFETs med nye 650V komponenter

Forbedret FoM-produkt booster effektiviteten betydeligt i strømforsyninger

Düsseldorf, Tyskland, 14. juli, 2020 – Toshiba Electronics Europe GmbH ("Toshiba") introducerer otte nye super junction N-kanal power-MOSFETs til udbygning af virksomhedens nyeste DTMOSVI-serie, der allerede har opnået bred anerkendelse på markedet takket være sin lave on-modstand og support af forøgede switching-hastigheder.

TK110N65Z, TK110Z65Z, TK110A65Z, TK125V65Z, TK155A65Z, TK170V65Z, TK190A65Z og TK210V65Z er alle komponenter forbedret til nominelt 650V og alle med meget attraktive parametre for ydelsen. MOSFET'erne giver designere en umiddelbar 40 procents reduktion af produktet af drain-source on-modstand og gate-drain ladningen (QGD) – det såkaldte FoM-produkt (figure of merit) sammenlignet med den foregående DTMOS-generation. Konsekvensen er, at de nye komponenter kan øge effektiviteten i switch-mode strømforsyninger med rundt regnet 0,36%, hvad der faktisk svarer til en betydelig reduktion af switch-tabene i forhold til den foregående generation.

De nye MOSFETs er tiltænkt brug i switch-mode strømforsyninger i et bredt udsnit af industrielt udstyr (inklusive datacenter-infrastrukturen, back-up forsyninger og effekttilpasning i blandt andet solcelle-paneler (PV)). Komponenterne vil give betydelige opgraderinger af ydelse, når de erstatter tidligere generationer af komponenter. TK110Z65Z, TK125V65Z, TK170V65Z og TK210V65Z har en Kelvin source-pin for optimal

styring og øget effektivitetspotentiale. TK110N65Z og TK110Z65Z passer i TO-247 kapslinger med 3/4 pins, mens TK110A65Z, TK155A65Z og TK190A65Z leveres i fuldt isolerede TO-220SIS huse. Endelig er TK125V65Z, TK170V65Z og TK210V65Z kapslede i 8mm x 8mm DFN-huse til overflademontage. Det medfører, at der nu findes DTMOSVI-løsninger, der kan passe til et hvilket som specifikt printformat.

Følg venligst nedenstående link for mere information om Toshiba's super-junction N-kanal MOSFETs:

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/400v-900v-mosfets.html>

###

Om Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) er den europæiske komponentforretning af [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE tilbyder europæiske kunder og virksomheder et bredt udsnit af innovative hard disk drive (HDD) produkter samt halvlederløsninger til automotive-, industrielle- og IoT-applikationer, bevægelsesstyring, telecom, netværk samt forbruger- og hvidevareapplikationer. Virksomhedens brede portefølje omfatter integrerede trådløse IC'er, effekthalvledere, mikrocontrollere, optiske halvledere, ASSPs samt diskrete komponenter lige fra dioder til logik-IC'er.

TEE har hovedkvarter i Düsseldorf, Tyskland, med kontorer i Frankrig, Italien, Spanien, Sverige og United Kingdom, hvorfra der udføres design, produktion, marketing og salg. Virksomhedens administrerende direktør er Hr. Tomoaki Kumagai.

For mere information besøg venligst Toshiba Electronics Europe's website på www.toshiba.semicon-storage.com.

Kontaktoplysninger til publikation:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Redaktionelle kontaktpersoner for yderligere information:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0) 1932 822 832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Udsendt for Toshiba Electronics Europe af:

Birgit Schöniger, Publitek

Tlf: +44 (0) 1582 390980

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Juli 2020

Ref. 7275_DK